

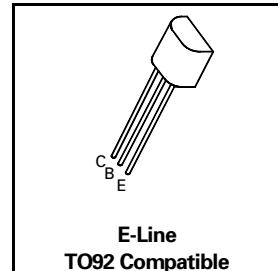
# PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTORS

ISSUE 1 – MARCH 94

## FEATURES

- \* 30 Volt  $V_{CEO}$
- \* 1 Amp continuous current
- \*  $P_{tot} = 1$  Watt

**ZTX549**  
**ZTX549A**



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-35	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-30	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-2	A
Continuous Collector Current	$I_C$	-1	A
Power Dissipation: at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ derate above $25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1 5.7	W mW/°C
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200	°C

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-35			V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-30			V	$I_C=10\text{mA}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			-0.1 -10	$\mu\text{A}$	$V_{CB}=-30\text{V}$ $V_{CB}=-30\text{V}, T_{amb}=100^\circ\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			-0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=-4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.25 -0.50	-0.50 -0.75	V	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}, I_B=200\text{mA}^*$
	ZTX549A			-0.30	V	$I_C=100\text{mA}, I_B=1\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.9	-1.25	V	$I_C=1\text{A}, I_B=100\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.85	-1	V	$I_C=1\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	70 80 40	200 130 80			$I_C=50\text{mA}, V_{CE}=-2\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=-2\text{V}^*$
	ZTX549		100	160	300	$I_C=500\text{mA}, V_{CE}=-2\text{V}^*$
	ZTX549A		150	200	500	$I_C=500\text{mA}, V_{CE}=-2\text{V}^*$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle ≤ 2%

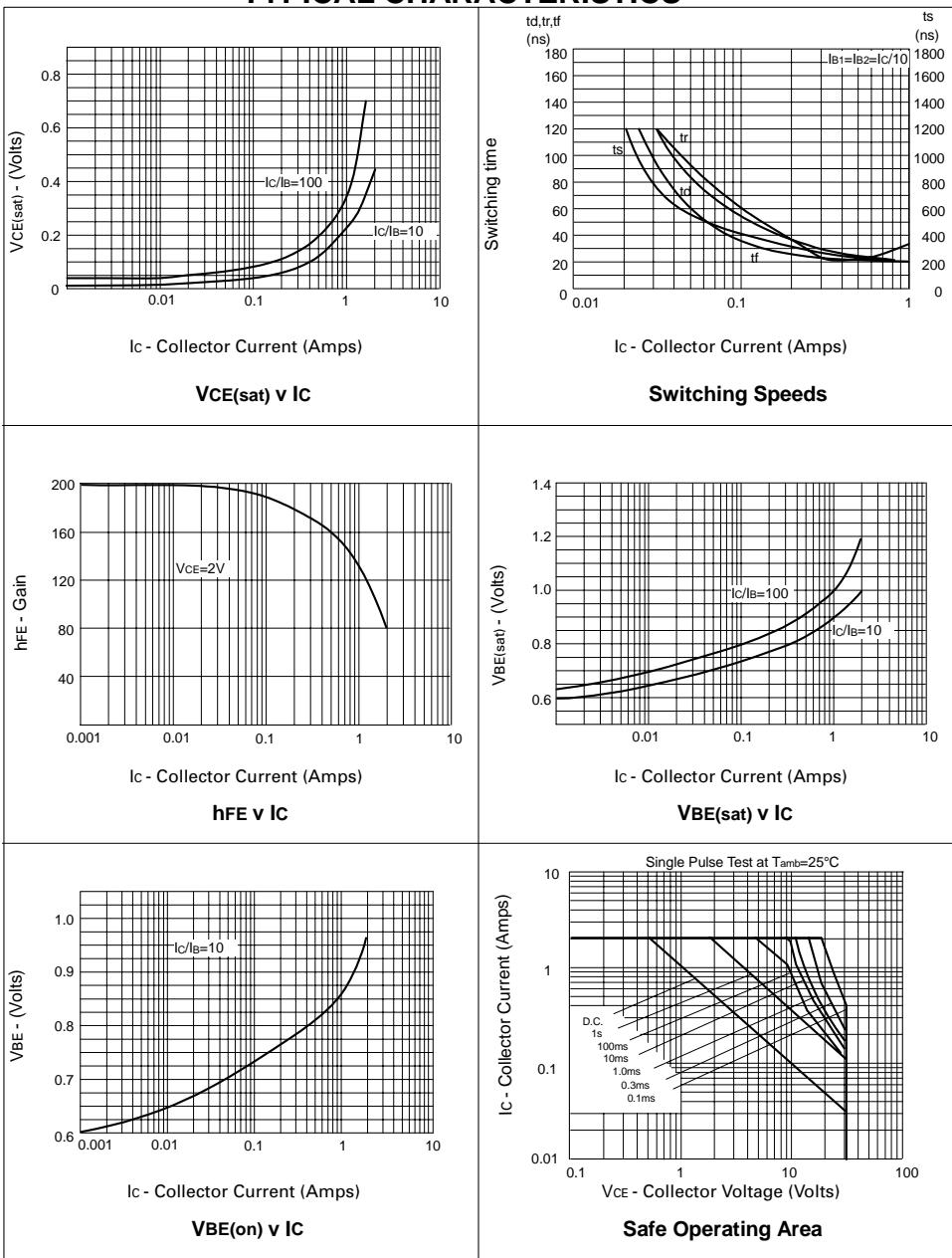
# ZTX549

# ZTX549A

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ ).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Transition Frequency	$f_T$	100			MHz	$I_C=100mA, V_{CE}=-5V$ $f=100MHz$
Output Capacitance	$C_{obo}$			25	pF	$V_{CB}=-10V, f=1MHz$
Switching Times	$t_{on}$		300		ns	$I_C=500mA, V_{CC}=-10V$
	$t_{off}$		50		ns	$I_{B1}=I_{B2}=50mA$

### TYPICAL CHARACTERISTICS





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331